

سوال ۱۱ سمعتیب

پردازهای زوایی چشم برای خواندن از

: M27C64A رم‌سازه EPROM

۸ از کمترین مدت زمان ممکن برای خواندن از آن tACC = tAVQV

۹ شدن داده در حین خواندن مدت زمان ممکن برای حفظ tELQV

۱۰ از کمترین مدت زمان ممکن برای tCE + tELQV

۱۱ داده موجود در آدرس دستور (LQ) مدت زمان ممکن برای حافظه

۱۲ از کمترین مدت زمان ممکن برای tOE + tGLQV

۱۳ امداده ممکن برای داده حفظ در آن مدت زمان

۱۴

سؤال ١ مقدمة

8

٦. SRAM را بازیابی کنید (مقدار حافظه) t_{AVQV}

9

٧. EPROM را بازیابی کنید (مقدار حافظه) t_{AVQV}
t_{ACC} = t_{TCE} = t_{TOE}

10

t_{CCE} = t_{TELQV}

11

t_{OE} = t_{TGLQV}

12

٨. SRAM را بازیابی کنید (مقدار حافظه) t_{DVWH}

13

٩. زمان بین سنت بایس (مقدار حافظه) t_{WHDX}

14

١٠. از زمان بین سنت بایس (مقدار حافظه) تا زمان (مقدار) t_{TWLWH}

15

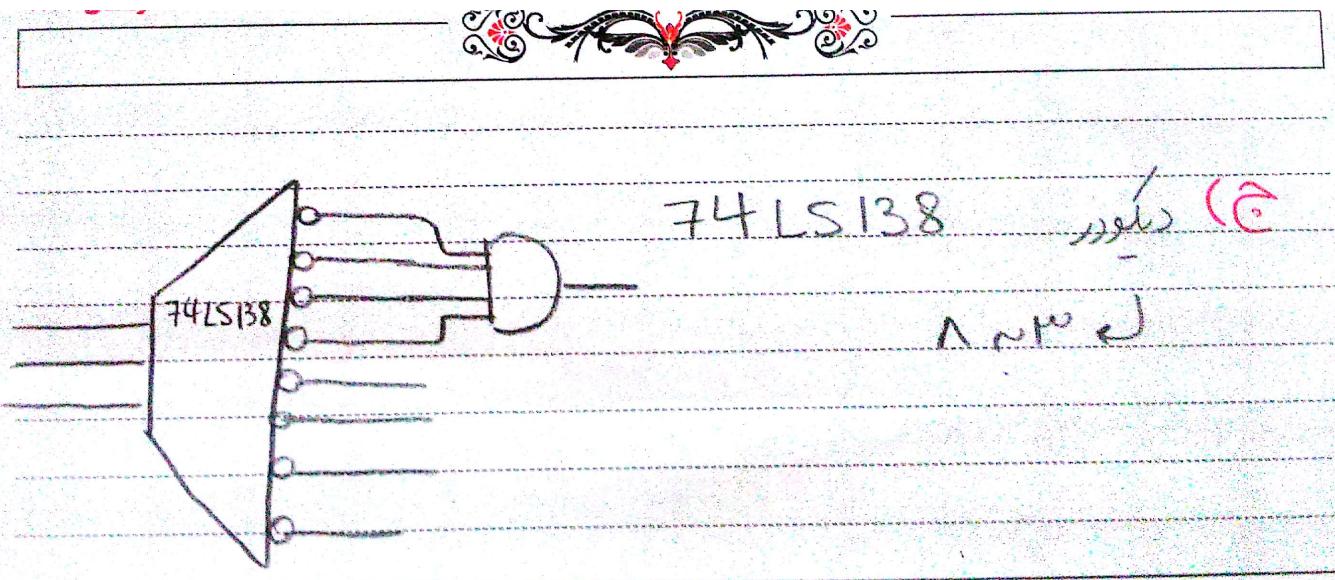
١١. زمان بین سنت بایس (مقدار حافظه) معین است و برداشت

16

Constant

20

١٢. عرض بایس (مقدار حافظه) t_{TWLWH}



74LS138

Y ~ P ~ J

(c)

٢٥٠٠١٤٥٢٩٠١٦٦٧٥٧٦

٢٥٠٠١٤٥٢٩٠١٦٦٧٥٧٦

٢٥٠٠١٤٥٢٩٠١٦٦٧٥٧٦

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٨

٠٠٠ }
٠٠١ } EPROM
٠١٠ }
٠١١ }
١٠٠ }
١٠١ } SRAM
١١٠ }
١١١ }

٣٠٨

٩

١٠

١١

١٢

LDI R16, 00H

LDI R17, 25H

LDI R20, 90H

CALL Memwrite

١٣

Memwrite:

LDI R18, FFH

OUT DDRA, R18

OUT DDRB, R18

OUT D.DRC, R18

OUT PORTA, R16

ANDI R17, 7EH

ORI R17, 40H

OUT PORTB, R17

OUT PORTC, R20

NOP

NOP

SBI PORTB, 07

NOP

RET

; 2 NOP = 2 clocks = 2 * 62.5 ns >

twLWH

20 = 120 ns

PCJ

15

with EEPROM, RAM, Flash Storage SLB



64 KB

256 KB

3 MB

Storage

(with ECC)

↳ non-volatile and programmable
with ECC



16

2 Aug 2013